

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年5月20日(20.05.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/095302 A1

(51) 国際特許分類:
C09J 201/00 (2006.01) C09J 7/25 (2018.01)
H01L 21/52 (2006.01) C09J 7/35 (2018.01)
H01L 21/301 (2006.01) C09J 7/38 (2018.01)
C09J 7/24 (2018.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/027885

(22) 国際出願日: 2020年7月17日(17.07.2020)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2019-206920 2019年11月15日(15.11.2019) JP

(71) 出願人: 昭和電工マテリアルズ株式会社 (SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 田澤 強(TAZAWA Tsuyoshi); 〒1006606
東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日

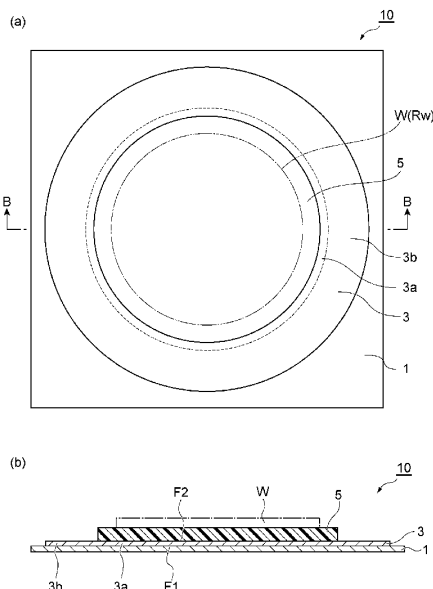
立化成株式会社内 Tokyo (JP). 木村 尚弘 (KIMURA Naohiro); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP). 森 修一(MORI Shuichi); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE PRODUCTION METHOD, DICING DIE-BONDING INTEGRATED FILM, AND PRODUCTION METHOD THEREFOR

(54) 発明の名称: 半導体装置の製造方法、並びにダイシング・ダイボンディング一体型フィルム及びその製造方法



(57) Abstract: The dicing die-bonding integrated film according to one aspect of the present disclosure includes a base material layer, an adhesive layer, and a pressure-sensitive adhesive layer that is disposed between the base material layer and the adhesive layer and has a first region in which the pressure-sensitive adhesive force with respect to the adhesive layer has been reduced beforehand by the irradiation of active energy rays. The pressure-sensitive adhesive force with respect to the adhesive layer in the first region is 6.0 N/25 mm to 12.5 N/25 mm inclusive as measured under the conditions of a temperature of 23°C, a peeling angle of 30°, and a peeling speed of 60 mm/minute.

(57) 要約: 本開示の一側面に係るダイシング・ダイボンディング一体型フィルムは、基材層と、接着剤層と、基材層と接着剤層の間に配置されており活性エネルギー線の照射によって接着剤層に対する粘着力が予め低下している第1の領域を有する粘着剤層とを備え、温度23°Cにおいて剥離角度30°及び剥離速度60 mm/分の条件で測定される、接着剤層に対する第1の領域の粘着力が6.0 N/25 mm以上12.5 N/25 mm以下である。

[続葉有]

NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))